



TECHNICAL DATA

PNP SILICON SMALL SIGNAL TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/392

Devices

2N3485A

2N3486A

Qualified Level

**JAN
JANTX
JANTXV**

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3485A	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current -- Continuous	I_C	600	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}^{(1)}$	P_T	0.4	W
@ $T_C = +25^\circ\text{C}^{(2)}$		2.0	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +200	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	0.439	$^\circ\text{mC/W}$
Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	87	$^\circ\text{C/W}$

1) Derate linearly 2.28 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A = +25^\circ\text{C}$

2) Derate linearly 11.43 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C = +25^\circ\text{C}$



TO-46*
(TO-206AB)

*See appendix A for
package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}$	$V_{(BR)CEO}$	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 60 \text{ Vdc}$	I_{CBO}		10 10	ηAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 3.5 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$	I_{EBO}		50 10	ηAdc μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS⁽³⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 0.1 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	2N3485A 2N3486A	40 75		
$I_C = 1.0 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	2N3485A 2N3486A	40 100		
$I_C = 10 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	2N3485A 2N3486A	40 100		
$I_C = 150 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	2N3485A 2N3486A	40 100	120 300	
$I_C = 500 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}$	2N3485A 2N3486A	40 50		
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150 \text{ mA}_\text{dc}, I_B = 15 \text{ mA}_\text{dc}$ $I_C = 500 \text{ mA}_\text{dc}, I_B = 50 \text{ mA}_\text{dc}$	$V_{CE(\text{sat})}$		0.4 1.6	V _d c
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 150 \text{ mA}_\text{dc}, I_B = 15 \text{ mA}_\text{dc}$ $I_C = 500 \text{ mA}_\text{dc}, I_B = 50 \text{ mA}_\text{dc}$	$V_{BE(\text{sat})}$		1.3 2.6	V _d c

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 1.0 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 10 \text{ V}_\text{dc}, f = 1.0 \text{ kHz}$ 2N3485A 2N3486A	h_{fe}	40 100		
Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 50 \text{ mA}_\text{dc}, V_{CE} = 20 \text{ V}_\text{dc}, f = 100 \text{ MHz}$	$ \text{h}_{fe} $	2.0	10	
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V}_\text{dc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{obo}		8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 2.0 \text{ V}_\text{dc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{ibo}		30	pF

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.